

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ПАТЕНТ

НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№ 2633899

Способ выращивания монокристаллов $Cd_{1-x}Zn_xTe$, где $0 \leq x \leq 1$, на затравку при высоком давлении инертного газа

Патентообладатель: *Общество с ограниченной ответственностью "КристалсНорд" (RU)*

Авторы: *Быкова Светлана Викторовна (RU),
Гольшев Владимир Дмитриевич (RU)*

Заявка № 2015154711

Приоритет изобретения 21 декабря 2015 г.

Дата государственной регистрации в

Государственном реестре изобретений

Российской Федерации 19 октября 2017 г.

Срок действия исключительного права

на изобретение истекает 21 декабря 2035 г.

Руководитель Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

Г.П. Ивлиев

